

Prof.Dr. BEYZA LİŞESİVDİN

Kişisel Bilgiler

İş Telefonu: [+90 312 202 1257](tel:+903122021257)

E-posta: beyzas@gazi.edu.tr

Web: <https://avesis.gazi.edu.tr/beyzas>

Uluslararası Araştırmacı ID'leri

ScholarID: IB33MAEAAAAJ

ORCID: 0000-0001-9278-0742

Publons / Web Of Science ResearcherID: AAA-8669-2020

ScopusID: 55319378800

Yoksis Araştırmacı ID: 109409

Eğitim Bilgileri

Doktora, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Türkiye 2005 - 2010

Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (YI) (Tezli), Türkiye 2003 - 2005

Lisans, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye 1998 - 2003

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Yarıiletken ince filmlerin X-ışını kırınımı ile kusur analizi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), 2010

Yüksek Lisans, $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ (GaAs ($x=0,15$) süperörgüsünün MBE ile büyütülmesi ve elektriksel-yapısal özelliklerinin belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (YI) (Tezli), 2005

Araştırma Alanları

Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 2022 - Devam Ediyor

Doç.Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 2015 - 2022

Öğretim Görevlisi Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 2010 - 2015

Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 2009 - 2010

Araştırma Görevlisi, Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 2005 - 2009

AKADEMİK İDARI DENEYİM

Orhun Değişim Programı Fizik Bölümü Koordinatörü, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, 2022 - Devam Ediyor
Researcher, Universitaet Ulm, Institute for Quantum Optics, Institute for Quantum Optics, 2019 - 2020
Araştırmacı, University of Essex, Engineering Faculty, Optoelectronic Materials & Devices Lab, 2013 - 2013

Verdiği Dersler

Fizik 1 (2. Şube), Lisans, 2020 - 2021, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2014 - 2015, 2013 - 2014
Fizik, Lisans, 2020 - 2021
Fizik Laboratuvarı, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017, 2015 - 2016, 2014 - 2015
Araştırma Projesi 2, Lisans, 2017 - 2018, 2015 - 2016, 2014 - 2015, 2013 - 2014
Fizik Laboratuvarı, Lisans, 2012 - 2013, 2011 - 2012

Yönetilen Tezler

LİŞESİVDİN B., GaAs/AlGaAs yapıların geniş akım bandındaki elektriksel karakterlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans, C.BEKTAŞ(Öğrenci), 2018

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

- I. **A structural analysis of ultrathin barrier (In)AlN/GaN heterostructures for GaN-based high-frequency power electronics**
Narin P., Kutlu-Narin E., Atmaca G., Sarikavak-Lisesivdin B., LİŞESİVDİN S. B., ÖZBAY E.
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, cilt.54, sa.5, ss.576-583, 2022 (SCI-Expanded)
- II. **gpaw-tools – higher-level user interaction scripts for GPAW calculations and interatomic potential based structure optimization**
Lişesivdin B., Lişesivdin S. B.
Computational Materials Science, cilt.204, ss.1-6, 2022 (SCI-Expanded)
- III. **Investigation of Structural and Optical Properties of ZnO Thin Films Grown on Different Substrates by Mist-CVD Enhanced with Ozone Gas Produced by Corona Discharge Plasma**
Kutlu-Narin E., Narin P., LİŞESİVDİN S. B., Sarikavak-Lisesivdin B.
ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS, cilt.2021, 2021 (SCI-Expanded)
- IV. **Structural parameters and electronic properties of 2D carbon allotrope: Graphene with a kagome lattice structure**
Sarikavak-Lisesivdin B., LİŞESİVDİN S. B., Ozbay E., Jelezko F.
CHEMICAL PHYSICS LETTERS, cilt.760, 2020 (SCI-Expanded)
- V. **A Comparative Study of AlGaN and InGaN Back-Barriers in Ultrathin-Barrier AlN/GaN Heterostructures**
Abbas J. M. A., Atmaca G., NARİN P., Kutlu E., Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B.
JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS, cilt.46, sa.8, ss.5278-5286, 2017 (SCI-Expanded)
- VI. **The effect of doping in different layers on 2DEG for ultrathin-barrier AlN/GaN heterostructures**
Al Abbas J. M., NARİN P., Atmaca G., Kutlu E., Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B.
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, cilt.11, ss.328-331, 2017 (SCI-Expanded)
- VII. **Electronic structure of beta-Si₃N₄ crystals with substitutional icosagen group impurities**
Kutlu E., NARİN P., Atmaca G., Sarikavak-Lisesivdin B., LİŞESİVDİN S. B., Ozbay E.
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, cilt.19, ss.278-282, 2017 (SCI-Expanded)
- VIII. **Effect of substitutional As impurity on electrical and optical properties of beta-Si₃N₄ structure**
Kutlu E., NARİN P., Atmaca G., Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B., Ozbay E.

MATERIALS RESEARCH BULLETIN, cilt.83, ss.128-134, 2016 (SCI-Expanded)

- IX. **Electronic properties of Li-doped zigzag graphene nanoribbons**
NARİN P., Kutlu E., Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B., Ozbay E.
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, cilt.84, ss.543-547, 2016 (SCI-Expanded)
- X. **Two dimensional electron gas in a hybrid GaN/InGaN/ZnO heterostructure with ultrathin InGaN channel layer**
Atmaca G., NARİN P., Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B.
PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, cilt.79, ss.67-71, 2016 (SCI-Expanded)
- XI. **Energy Relaxation of Electrons in InGaN Quantum Wells**
Sarikavak-Lisesivdin B., LİŞESİVDİN S. B., Balkan N., Atmaca G., NARİN P., Cakmak H., ÖZBAY E.
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, sa.4, ss.1565-1569, 2015 (SCI-Expanded)
- XII. **Electron Transport Properties of Two-Dimensional Electron Gas in $BexZn_{1-x}O/ZnO$ Heterostructures**
Atmaca G., Narin P., Lisesivdin S. B., Kasap M., Sarikavak-Lisesivdin B.
PHILOSOPHICAL MAGAZINE, cilt.95, sa.1, ss.79-89, 2015 (SCI-Expanded)
- XIII. **Numerical optimization of two-dimensional electron gas in $MgxZn_{1-x}O/ZnO$ heterostructures ($0.10 < x < 0.30$)**
Sarikavak-Lisesivdin B.
PHILOSOPHICAL MAGAZINE, cilt.93, sa.9, ss.1124-1131, 2013 (SCI-Expanded)
- XIV. **First-principles calculations of Pd-terminated symmetrical armchair graphene nanoribbons**
Kuloglu A. F., Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B., Ozbay E.
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, cilt.68, ss.18-22, 2013 (SCI-Expanded)
- XV. **The effect of $In_xGa_{1-x}N$ back-barriers on the dislocation densities in $Al_{0.31}Ga_{0.69}N/AlN/GaN/In_xGa_{1-x}N/GaN$ heterostructures ($0.05 \leq x \leq 0.14$)**
Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B., Ozbay E.
CURRENT APPLIED PHYSICS, cilt.13, sa.1, ss.224-227, 2013 (SCI-Expanded)
- XVI. **Ab initio study of Ru-terminated and Ru-doped armchair graphene nanoribbons**
Sarikavak-Lisesivdin B., Lisesivdin S. B., Ozbay E.
MOLECULAR PHYSICS, cilt.110, sa.18, ss.2295-2300, 2012 (SCI-Expanded)
- XVII. **Grain Boundary Related Electrical Transport in Al-rich $Al_xGa_{1-x}N$ Layers Grown by Metal-Organic Chemical Vapor Deposition**
Yildiz A., Tasli P., Sarikavak B., Lisesivdin S. B., Ozturk M. K., Kasap M., Ozcelik S., Ozbay E.
SEMICONDUCTORS, cilt.45, sa.1, ss.33-36, 2011 (SCI-Expanded)
- XVIII. **Numerical simulation of novel ultrathin barrier n-GaN/InAlN/AlN/GaN HEMT structures: Effect of indium-mole fraction, doping and layer thicknesses**
Tasli P., Sarikavak B., Atmaca G., Elibol K., Kuloglu A. F., Lisesivdin S. B.
PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.405, sa.18, ss.4020-4026, 2010 (SCI-Expanded)
- XIX. **Influence of thermal annealing on the structure and optical properties of d.c. magnetron sputtered titanium dioxide thin films**
Kars İ., Cetin S. Ş., KINACI B., Sarikavak B., Bengi A., Altuntas H., Ozturk M. K., Ozcelik S.
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, cilt.42, ss.1247-1251, 2010 (SCI-Expanded)
- XX. **Interface state density analyzing of Au/TiO₂(rutile)/n-Si Schottky barrier diode**
Altuntas H., Bengi A., Asar T., Aydemir U., Sarikavak B., Özen Y., Altindal Ş., Ozcelik S.
SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS, cilt.42, sa.6-7, ss.1257-1260, 2010 (SCI-Expanded)
- XXI. **Interdiffusion phenomena in InGaAs/GaAs superlattice structures**
Sarikavak B., Ozturk M. K., Mammadov T. S., Ozcelik S.
CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY, cilt.45, sa.5, ss.517-524, 2010 (SCI-Expanded)
- XXII. **Structural analysis of an InGaN/GaN based light emitting diode by X-ray diffraction**
Ozturk M. K., Hongbo Y., Sarikavak B., Korcak S., Ozcelik S., Ozbay E.
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, cilt.21, sa.2, ss.185-191, 2010 (SCI-Expanded)
- XXIII. **Effects of annealing on the structural properties of GaAs-based quantum well solar cells**

Asar T., Sarikavak B., Ozturk M. K., Mammadov T., Ozelik S.

JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, cilt.11, sa.11, ss.1627-1631, 2009 (SCI-Expanded)

XXIV. **MBE-growth and characterization of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$ ($x=0.15$) superlattice**

Sarikavak B., Oezturk M. K., Altuntas H., Mammedov T. S., Altindal Ş., Oezcelik S.

REVISTA MEXICANA DE FISICA, cilt.54, sa.6, ss.416-421, 2008 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

I. **Preparation of Carbon Nanospheres by An Autoclave Type Reactor**

Lişesivdin B.

Balkan Physics Letters, cilt.1, ss.401-403, 2008 (Hakemli Dergi)

II. **Analyze of Defects in InGaAs epilayer with High resolution X ray diffraction**

Lişesivdin B.

FİZİKA, cilt.1, ss.179-183, 2008 (Hakemli Dergi)

III. **Electrical Characteristics of Au In_{0.25}Ga_{0.75}As GaAs Structures**

Lişesivdin B.

FİZİKA, cilt.1, ss.261-263, 2008 (Hakemli Dergi)

IV. **The structural and Optical Analysis of the Graded 1 micrometer Thick n GaAs_{1-x}P_x GaAs Structures**

Lişesivdin B.

FİZİKA, cilt.1, sa.1, ss.18-20, 2008 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

I. **Chapter 15: The Effects of the Interaction of Transition Metals on the Electronic Properties of the Graphene Nanosheets and Nanoribbons**

Lişesivdin S. B., Lişesivdin B., Özbay E.

Graphene Science Handbook Vol.3, Mahmood Aliofkhaezaei, Nasar Ali, William I. Milne, Cengiz S. Ozkan, Stanislaw Mitura, Juana L. Gervasoni, Editör, CRC, New York, Florida, ss.221-235, 2016

II. **Nanoteknoloji Devrimini Anlamak**

LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.

Nobel Yayınevi, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

I. **Doped Tin Carbide (SnC) Based Nanostructure for Applications In Nanoelectronics**

Ansari M. T., NARİN P., LİŞESİVDİN S. B., LİŞESİVDİN B., ÖZBAY E.

9th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, Ankara, Türkiye, 22 Eylül 2022, ss.150

II. **Germanene: DFT investigation of Electronic and Optical Properties changing with Au and Cu doping**

Han T., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.

9th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, Ankara, Türkiye, 22 Eylül 2022, ss.170

III. **Multi-Code, Low-Barrier Python Toolkit For MD/DFT Studies**

LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.

9th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation, Ankara, Türkiye, 22 Eylül 2022, ss.104

IV. **gpaw-tools: UI/GUI scripts for GPAW software**

LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.

- V. **DFT Investigation of Electronic and Optical Properties of Silver Doped Germanene**
Han T., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
Turkish Physical Society 37th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2021, ss.240
- VI. **Spin-polarized DFT calculations of nitrogen-vacancy color centers in diamond with various XC potentials**
LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B., ÖZBAY E., Jelezko F.
Quantum Optics and Informatics Meeting – 4 (Kobit 4), İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2020
- VII. **Calculation of Carrier Density and probability density calculations of heterostructures**
LİŞESİVDİN B.
WITAM 2018, 21 - 23 Eylül 2018
- VIII. **HR-XRD Characterizations of Ultra Thin Barrier HEMT Structures**
LİŞESİVDİN B.
WITAM 2018, 21 - 23 Eylül 2018
- IX. **Electrical characteristics of GaAs AlGaAs Structures in the wide Frequency ranges**
Bektaş C., GÜNEŞ M., LİŞESİVDİN B., Henini M., ALTINDAL Ş.
2nd International Congress on The World of Technology and Advanced Materials, Kırşehir, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2016
- X. **Ultrathin Bariyer Sahip AlN GaN ve InAlN GaN HEMT Yapılarının Yapısal ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi**
Narin P., Kutlu E., Atmaca G., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B., ÖZBAY E.
18. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 23 Eylül 2016, cilt.72
- XI. **Ultrathin Bariyerli GaN Temelli HEMT lerde Elektron Gazının Elektriksel Özellikleri ve Saçılma Analizleri**
Öztürk M., Arslan E., Narin P., LİŞESİVDİN S. B., LİŞESİVDİN B., ÖZBAY E.
18. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Türkiye, 23 Eylül 2016, cilt.50
- XII. **Numerical Investigation Of 2DEG Properties In Ultrathin Barrier AlN GaN Heterostructures With AlGaN and InGaN Back Barriers**
Al Abbas J. M., Atmaca G., Narin P., Kutlu E., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
18. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 23 Eylül 2016, cilt.47
- XIII. **Ultrathin AlN GaN Çoklu Yapılarda Farklı Katmanların Katılmasının 2BEG Üzerine etkisi**
AL ABBAS J. M., NARİN P., ATMACA G., KUTLU E., LİŞESİVDİN S. B., LİŞESİVDİN B.
ADIM Fizik Günleri V, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016
- XIV. **Ultrathin Bariyerli AlN GaN Çoklu Yapılarda Farklı Katmanların 2BEG Üzerine Etkisi**
Al Abbas J., Atmaca G., Narin P., Kutlu E., LİŞESİVDİN S. B., LİŞESİVDİN B.
ADIM Physics Congress V, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.164
- XV. **P tipi ve N tipi InGaN Arka Bariyerli Ultrathin AlInN GaN Çoklu Yapılarda İki Boyutlu Elektron Gazı**
Al Abbas J., Narin P., Kutlu E., Atmaca G., LİŞESİVDİN S. B., LİŞESİVDİN B.
ADIM Physics Congress V, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.163
- XVI. **Li Katkılı Zigzag Kenarlı Grafen Nano Şeritlerin Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi**
Kutlu E., Narin P., Atmaca G., Al Abbas J., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
ADIM Physics Congress V, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.151
- XVII. **Li Katkılı Zigzag Kenarlı Grafen Nano Şeritlerin Elektronik Özelliklerinin DFT ile İncelenmesi**
KUTLU E., NARİN P., ATMACA G., AL ABBAS J. M., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
ADIM Fizik Günleri V, Eskişehir, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016
- XVIII. **ELECTRONIC PROPERTIES OF ARMCHAIR GRAPHENE NANORIBBONS WITH NICKEL TERMINATION**
ÇAĞIRTEKİN A. O., NARİN P., LİŞESİVDİN B.
9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2015
- XIX. **The effect of in situ Si₃N₄ passivation on hot electron energy relaxation rates in AlGaIn GaN Heterostructures**

Atmaca G., Malin T., Kutlu E., Ardah Ş., Narin P., Mansurov V., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B., TIRAŞ E., Zhuravlev K.
GaN InN AlN 2015, 23 - 25 Mayıs 2015

- XX. **Investigation of Optical Properties of the Beta Si₃N₄ Structure doped with some group IIIA Elements**
Narin P., Kutlu E., Atmaca G., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
1. Uluslararası Organik Elektronik Malzeme Teknolojileri Konferansı, 25 - 28 Mart 2015
- XXI. **Electrical characteristics of GaAs AlGaAs Structures in the wide Frequency and applied bias voltage ranges at room temperature**
GÜNEŞ M., LİŞESİVDİN B., PESEN E., Henini M., ALTINDAL Ş.
1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT'2015), 25 - 28 Mart 2015
- XXII. **Two diodes model in the forward bias current voltage I V characteristics of Al_{0.33}Ga_{0.67}As n GaAs at room temperature**
GÜNEŞ M., LİŞESİVDİN B., Henini M., ALTINDAL Ş.
1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT'2015), 25 - 28 Mart 2015
- XXIII. **First Principle Calculations of Electrical Properties of Insulator Wurtzite Beta Si₃N₄ with the Aluminum Indium and Gallium Impurities**
Kutlu E., Narin P., Atmaca G., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT'2015), 25 - 28 Mart 2015
- XXIV. **Investigation of Optical Properties of the Si₃N₄ structure doped with some Group IIIA Elements**
Narin P., Kutlu E., Atmaca G., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
1st International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT'2015), 25 - 28 Mart 2015
- XXV. **First Principle Calculations of Electrical Properties of Insulator Wurtzite the Si₃N₄ with the Aluminum Indium and Gallium Impurities**
Kutlu E., Narin P., Atmaca G., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
1. Uluslararası Organik Elektronik Malzeme Teknolojileri Konferansı, 25 - 28 Mart 2015
- XXVI. **The Effect of In Situ Si₃N₄ Passivation on Hot Electron energy Relaxation Rates in AlGaN GaN Heterostructures**
Atmaca G., Malin T., Kutlu E., Ardah Ş., Narin P., Mansurov V., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B., TIRAŞ E., Zhuravlev K.
10th All-Russian Conference Gallium, aluminum and indium nitrides, 23 - 25 Mart 2015
- XXVII. **Ab initio study of oxygen and arsenic impurities on non-linear optical properties of β-Si₃N₄ material**
Kutlu E., NARİN P., Atmaca G., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B.
Конференция И Школа Молодых Учёных По Актуальным Проблемам Физики Полупроводниковых Структур, Novosibirsk, Rusya, 15 Eylül 2014, ss.77
- XXVIII. **Investigation of the effect of the arsenic impurity on the electronic and optical properties of β-Si₃N₄ dielectric material**
LİŞESİVDİN S. B., Kutlu E., NARİN P., Atmaca G., LİŞESİVDİN B.
Turkish Physical Society 31th International Physics Congress, Muğla, Türkiye, 21 Temmuz 2014, ss.402
- XXIX. **A Numerical Investigation on Electronic Properties of Two Dimensional Electron Gas in Be_xZn_{1-x}O/ZnO Heterostructures**
NARİN P., Atmaca G., LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B., KASAP M.
Turkish Physical Society 30th International Physics Congress, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2013, ss.529
- XXX. **First Principles Study of Interaction Between Ru and Graphene Nanoribbons**
LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B., ÖZBAY E.
2nd Int. Conf. on Comp. for Sci. and Techno, Niğde, Türkiye, 9 - 11 Temmuz 2012, ss.70
- XXXI. **AlGaN/GaN-temelli Yüksek Hareketliliğe Sahip Transistorlerde InGaN Geribariyerin Dislokasyon Yönelimine Etkisi**
LİŞESİVDİN B., LİŞESİVDİN S. B., ÖZBAY E.
ADIM Physics Congress II, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2012, ss.131
- XXXII. **Influence of thermal annealing on the structure and optical properties of DC magnetron sputtered titanium dioxide thin films**
Kars Durukan İ., Aydın S. Ş., Kınacı B., Lişesivdin B., Bengi A., Altuntaş H., Öztürk M., Özçelik S.

Desteklenen Projeler

Lişesivdin S. B., Lişesivdin B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MistCVD ile büyütülen p-tipi Cu₂O yarıiletken incefilmler ile Ga₂O₃/Cu₂O p-n kavşak üretimi ve ilgili hesaplamalı çalışmaları, 2022 - 2023

Durmuş P., Lişesivdin B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ARAYÜZEY TABAKALI METAL/YARIİLETKEN (MS) YAPILARDA ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİN RADYASYON VE FREKANSA BAĞLI İNCELENMESİ, 2018 - 2020

LİŞESİVDİN B., TÜBİTAK Projesi, Ultra-İnce Bariyerli Gan-Temelli Yarıiletken Çokluyapıların Elektriksel Ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi114F508, 2015 - 2017

Lişesivdin S. B., Lişesivdin B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, MgxZn_{1-x}O/ZnO ve BexZn_{1-x}O/ZnO çokluyapılarını temel alan transistörlerin numerik optimizasyonu, 2012 - 2013

Lişesivdin B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı Nadir Toprak Oksitlerinin yapısal elastik elektronik termodinamik ve titreşimsel özelliklerinin ab initio yöntemlerle incelenmesi, 2012 - 2012

LİŞESİVDİN B., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Bazı Nadir Toprak Oksitlerinin yapısal, elastik, elektronik, termodinamik ve titreşimsel özelliklerinin ab-initio yöntemlerle incelenmesi, 2011 - 2012

Metrikler

Yayın: 64

Atıf (WoS): 159

Atıf (Scopus): 171

H-İndeks (WoS): 7

H-İndeks (Scopus): 8